

SEGUIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN
DE ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS CONDUCENTES A TÍTULOS OFICIALES

**MÁSTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGÍAS
ELECTRÓNICAS POR LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (Coord.) Y LA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID**

Fac. Ciencias

Curso 2024-2025

**Perfil del Currículum Vitae del Personal Docente e
Investigador de la USAL que imparte docencia en la
titulación.
Curso 2024-2025**

(Más información en el enlace <https://produccioncientifica.usal.es/>)

Apellidos y nombre: García Sánchez, Sergio
Departamento: Física Aplicada
Área de conocimiento: Electrónica
Categoría: Profesor Permanente Laboral Titular

DOCENCIA (titulación y asignatura)

GRADO EN FÍSICA - LABORATORIO DE FISICA

DOBLE TITULACIÓN GRADO EN FÍSICA Y MATEMÁTICAS - LABORATORIO DE FISICA

MÁSTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGÍAS ELECTRÓNICAS - SENSORES INTELIGENTES Y ELECTRÓNICA PARA IoT

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN - ARQUITECTURA DE COMPUTADORES I

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN - SISTEMAS DE ENTRADA/SALIDA

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA - FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA

GRADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES - FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA

DOBLE TITULACIÓN ING. INFORM. SISTEMAS INFORMACIÓN/GR. INFORMA. Y DOCUMENT. - ARQUITECTURA DE COMPUTADORES I

DOBLE TITULACIÓN GR. EN ING.DE MATERIALES/ GR. EN ING. MECÁNICA - FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA

INVESTIGACIÓN

Grupo de Investigación

Investigador del Grupo de Investigación: Nanodispositivos electrónicos de alta frecuencia

Líneas de investigación:

Diseño y simulación de nanodispositivos electrónicos de alta frecuencia Caracterización DC, RF y de ruido de dispositivos electrónicos

Ruido en materiales y dispositivos semiconductores Modelado de grafeno (monocapa y bicapa) y dispositivos de grafeno par

Investigador del Grupo de Investigación: Nanodispositivos electrónicos de alta frecuencia

Líneas de investigación:

Diseño y simulación de nanodispositivos electrónicos de alta frecuencia Caracterización DC, RF y de ruido de dispositivos electrónicos

Ruido en materiales y dispositivos semiconductores Modelado de grafeno (monocapa y bicapa) y dispositivos de grafeno par

Proyectos

Nuevas soluciones con diodos y transistores para sensado y comunicaciones de banda ancha en el rango THz

Mejora de la tecnología de diodos de barrera Schottky de GaN para electrónica eficiente de alta potencia

Diodos Gunn planares de GaN con terminal de sustrato para generación de alta potencia en el rango de sub-THz

Programas de doctorado

No constan

GESTIÓN

Cargos académicos

IP del Proyecto (R1) de Refº. SA136P23 Mejora de la tecnología de diodos de barrera Schottky de GaN

Apellidos y nombre: García Vasallo, Beatriz
Departamento: Física Aplicada
Área de conocimiento: Electrónica
Categoría: Profesor Titular de Universidad

DOCENCIA (titulación y asignatura)

MÁSTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGÍAS ELECTRÓNICAS - ELECTRÓNICA PARA COMPUTACIÓN NEUROMÓRFICA

MÁSTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGÍAS ELECTRÓNICAS - PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS

MU PROFESOR E.S.O. Y BACHILLERATO, FORM. PROF. Y E. IDIOMAS - HISTORIA EN LA ESPECIALIDAD DE FÍSICA Y QUÍMICA

MU PROFESOR E.S.O. Y BACHILLERATO, FORM. PROF. Y E. IDIOMAS - INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN LA ESPECIALIDAD DE FÍSICA Y QUÍMICA

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN - ARQUITECTURA DE COMPUTADORES I

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN - SISTEMAS DE ENTRADA/SALIDA

GRADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES - COMPORTAMIENTO ELECTRÓNICO DE MATERIALES

DOBLE TITULACIÓN ING. INFORM. SISTEMAS INFORMACIÓN/GR. INFORMA. Y DOCUMENT. - ARQUITECTURA DE COMPUTADORES I

DOBLE TITULACIÓN GR. EN ING.DE MATERIALES/ GR. EN ING. MECÁNICA - COMPORTAMIENTO ELECTRÓNICO DE MATERIALES

INVESTIGACIÓN

Grupo de Investigación

Investigador del Grupo de Investigación: Nanodispositivos electrónicos de alta frecuencia

Lineas de investigación:

Diseño y simulación de nanodispositivos electrónicos de alta frecuencia Caracterización DC, RF y de ruido de dispositivos electrónicos
Ruido en materiales y dispositivos semiconductores Modelado de grafeno (monocapa y bicapa) y dispositivos de grafeno par

Proyectos

Nuevas soluciones con diodos y transistores para sensado y comunicaciones de banda ancha en el rango THz

Mejora de la tecnología de diodos de barrera Schottky de GaN para electrónica eficiente de alta potencia

Diodos Gunn planares de GaN con terminal de sustrato para generación de alta potencia en el rango de sub-THz

Programas de doctorado

Prog. Doctorado: FÍSICA APLICADA Y TECNOLOGÍA (R.D. 99/2011) - CodirectorTesis

GESTIÓN

Cargos académicos

VOCAL COMISIONES ESTATUTARIAS DE CENTRO - ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ZAMORA

IP del Proyecto (N1) de Refª. PDC2023-145896-I00 Diodos Gunn planares de GaN con terminal de sustrat

Apellidos y nombre: González Sánchez, Tomás
Departamento: Física Aplicada
Área de conocimiento: Electrónica
Categoría: Catedrático de Universidad

DOCENCIA (titulación y asignatura)

GRADO EN FÍSICA - ELECTRONICA FISICA

GRADO EN FÍSICA - LABORATORIO DE ELECTRONICA

DOBLE TITULACIÓN GRADO EN FÍSICA Y MATEMÁTICAS - ELECTRONICA FISICA

DOBLE TITULACIÓN GRADO EN FÍSICA Y MATEMÁTICAS - LABORATORIO DE ELECTRONICA

MÁSTER U. EN FÍSICA Y MATEMÁTICAS - NANO ELECTRÓNICA Y APLICACIONES DE ALTA FRECUENCIA

MÁSTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGÍAS ELECTRÓNICAS - DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS EMERGENTES

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA - ELECTRÓNICA Y ELECTROTECNIA

INVESTIGACIÓN

Grupo de Investigación

Investigador del Grupo de Investigación: Nanodispositivos electrónicos de alta frecuencia

Lineas de investigación:

Diseño y simulación de nanodispositivos electrónicos de alta frecuencia Caracterización DC, RF y de ruido de dispositivos electrónicos Ruido en materiales y dispositivos semiconductores Modelado de grafeno (monocapa y bicapa) y dispositivos de grafeno par

Proyectos

Nuevas soluciones con diodos y transistores para sensado y comunicaciones de banda ancha en el rango THz

Mejora de la tecnología de diodos de barrera Schottky de GaN para electrónica eficiente de alta potencia

Diodos Gunn planares de GaN con terminal de sustrato para generación de alta potencia en el rango de sub-THz

Programas de doctorado

Prog. Doctorado: FÍSICA APLICADA Y TECNOLOGÍA (R.D. 99/2011) - Tutor

Prog. Doctorado: FÍSICA APLICADA Y TECNOLOGÍA (R.D. 99/2011) - Codirector Tesis

Prog. Doctorado: FÍSICA APLICADA Y TECNOLOGÍA (R.D. 99/2011) - Director Tesis

GESTIÓN

Cargos académicos

IP del Proyecto (R1) de Ref^o. SA136P23 Mejora de la tecnología de diodos de barrera Schottky de GaN

Apellidos y nombre: Íñiguez de la Torre Mulas, Ignacio
Departamento: Física Aplicada
Área de conocimiento: Electrónica
Categoría: Profesor Titular de Universidad

DOCENCIA (titulación y asignatura)

GRADO EN FÍSICA - FISICA III

GRADO EN FÍSICA - FISICA COMPUTACIONAL

GRADO EN FÍSICA - LABORATORIO DE ELECTRONICA

DOBLE TITULACIÓN GRADO EN FÍSICA Y MATEMÁTICAS - FISICA III

DOBLE TITULACIÓN GRADO EN FÍSICA Y MATEMÁTICAS - FISICA COMPUTACIONAL

DOBLE TITULACIÓN GRADO EN FÍSICA Y MATEMÁTICAS - LABORATORIO DE ELECTRONICA

MÁSTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGÍAS ELECTRÓNICAS - TEORÍA Y TÉCNICAS DE MEDIDA E INSTRUMENTACIÓN

INVESTIGACIÓN

Grupo de Investigación

Investigador del Grupo de Investigación: Nanodispositivos electrónicos de alta frecuencia

Lineas de investigación:

Diseño y simulación de nanodispositivos electrónicos de alta frecuencia Caracterización DC, RF y de ruido de dispositivos electrónicos
Ruido en materiales y dispositivos semiconductores Modelado de grafeno (monocapa y bicapa) y dispositivos de grafeno par

Proyectos

Nuevas soluciones con diodos y transistores para sensado y comunicaciones de banda ancha en el rango THz

Mejora de la tecnología de diodos de barrera Schottky de GaN para electrónica eficiente de alta potencia

Diodos Gunn planares de GaN con terminal de sustrato para generación de alta potencia en el rango de sub-THz

Programas de doctorado

Prog. Doctorado: FÍSICA APLICADA Y TECNOLOGÍA (R.D. 99/2011) - DirectorTesis

Prog. Doctorado: FÍSICA APLICADA Y TECNOLOGÍA (R.D. 99/2011) - Tutor

Prog. Doctorado: FÍSICA APLICADA Y TECNOLOGÍA (R.D. 99/2011) - CodirectorTesis

GESTIÓN

Cargos académicos

IP del Proyecto (N1) de Refª. PID2023-147555OB-I00 Nuevas soluciones con diodos y transistores para

Apellidos y nombre: Mateos López, Javier
Departamento: Física Aplicada
Área de conocimiento: Electrónica
Categoría: Catedrático de Universidad

DOCENCIA (titulación y asignatura)

GRADO EN FÍSICA - LABORATORIO DE ELECTRONICA

GRADO EN FÍSICA - PRACTICAS EXTERNAS II (9 Créditos)

GRADO EN FÍSICA - PRACTICAS EXTERNAS VIII (6 Créditos)

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA - FUNDAMENTOS FÍSICOS

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA - SISTEMAS DIGITALES PROGRAMABLES

DOBLE TITULACIÓN GRADO EN FÍSICA Y MATEMÁTICAS - LABORATORIO DE ELECTRONICA

DOBLE TITULACIÓN GRADO EN ESTADÍSTICA Y EN INGENIERÍA INFORMÁTICA - FUNDAMENTOS FÍSICOS

MÁSTER U. EN FÍSICA Y MATEMÁTICAS - NANO ELECTRÓNICA Y APLICACIONES DE ALTA FRECUENCIA

MÁSTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGÍAS ELECTRÓNICAS - OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA EN ELECTRÓNICA DE POTENCIA

MÁSTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGÍAS ELECTRÓNICAS - PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS

MÁSTER U. ESTUDIOS DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN - RETOS SOCIALES DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE FRONTERA

INVESTIGACIÓN

Grupo de Investigación

Investigador Principal del Grupo de Investigación: Nanodispositivos electrónicos de alta frecuencia

Líneas de investigación:

Diseño y simulación de nanodispositivos electrónicos de alta frecuencia Caracterización DC, RF y de ruido de dispositivos electrónicos

Ruido en materiales y dispositivos semiconductores Modelado de grafeno (monocapa y bicapa) y dispositivos de grafeno par

Proyectos

Nuevas soluciones con diodos y transistores para sensado y comunicaciones de banda ancha en el rango THz

Caracterización, análisis e intervención en la prevención de riesgos laborales en entornos de trabajo tradicionales mediante la aplicación de tecnologías disruptivas

Mejora de la tecnología de diodos de barrera Schottky de GaN para electrónica eficiente de alta potencia

Evaluación de proyectos I+D+i

Diodos Gunn planares de GaN con terminal de sustrato para generación de alta potencia en el rango de sub-THz

Programas de doctorado

Prog. Doctorado: FÍSICA APLICADA Y TECNOLOGÍA (R.D. 99/2011) - Tutor

Prog. Doctorado: FÍSICA APLICADA Y TECNOLOGÍA (R.D. 99/2011) - Codirector Tesis

Prog. Doctorado: FÍSICA APLICADA Y TECNOLOGÍA (R.D. 99/2011) - Director Tesis

GESTIÓN

Cargos académicos

IP del Proyecto (N1) de Refª. PID2023-147555OB-I00 Nuevas soluciones con diodos y transistores para

MIEMBRO COMITÉ EDITORIAL DE LA REVISTA (Q2) Sensors

VOCAL COMISIONES DE GRADO - GRADO EN FÍSICA - FACULTAD DE CIENCIAS

IP del Proyecto (N1) de Refª. PDC2023-145896-I00 Diodos Gunn planares de GaN con terminal de sustrat

Apellidos y nombre: Meziani ..., Yahya Moubarak
Departamento: Física Aplicada
Área de conocimiento: Electrónica
Categoría: Catedrático de Universidad

DOCENCIA (titulación y asignatura)

GRADO EN FÍSICA - INSTRUMENTACION ELECTRONICA
GRADO EN FÍSICA - PRACTICAS EXTERNAS VIII (6 Créditos)
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA - PERIFÉRICOS
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA - PRÁCTICAS EXTERNAS
GRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA - ELECTRÓNICA Y ELECTROTECNIA
DOBLE TITULACIÓN GRADO EN FÍSICA Y MATEMÁTICAS - INSTRUMENTACION ELECTRONICA
MÁSTER U. EN FÍSICA Y MATEMÁTICAS - CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y DISPOSITIVOS
MÁSTER U. EN FÍSICA Y MATEMÁTICAS - NANO ELECTRÓNICA Y APLICACIONES DE ALTA FRECUENCIA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGÍAS ELECTRÓNICAS - TEORÍA Y TÉCNICAS DE MEDIDA E INSTRUMENTACIÓN

INVESTIGACIÓN

Grupo de Investigación

Investigador del Grupo de Investigación: GRUPO DE NANOTECNOLOGÍA Y MATERIALES CUÁNTICOS

Líneas de investigación:

Coloides e Interfases Nanosistemas cuánticos y Física No Lineal Terahercios y Células solares Materiales Cuánticos, grafeno y otros materiales 2D Twistrónica y nanodispositivos cuánticos Materiales para la energía Física de Superficies y caracterización a

Investigador del Grupo de Investigación: Nanoelectrónica para tecnología de terahercios

Líneas de investigación:

Coloides e Interfases Nanosistemas cuánticos y Física No Lineal Terahercios y Células solares Materiales Cuánticos, grafeno y otros materiales 2D Twistrónica y nanodispositivos cuánticos Materiales para la energía Física de Superficies y caracterización a

Proyectos

Low dimensional Materials efficient Neuromorphic Applications (LAMINA)

Transistores FET basados en Si y materiales 2d avanzados para tecnología super-Terahercios

Materiales Cuánticos para Nanodispositivos y Celulas Solares de Nueva Generación (CuNaSol)

Prototipo de detector avanzado en la banda de terahercios para aplicaciones de seguridad e imágenes (PrDATA)

CHIROTRONICS "Controlling chirality in atomically thin quantum electronic materials"

Programas de doctorado

Prog. Doctorado: FÍSICA APLICADA Y TECNOLOGÍA (R.D. 99/2011) - DirectorTesis

Prog. Doctorado: FÍSICA APLICADA Y TECNOLOGÍA (R.D. 99/2011) - CodirectorTesis

Prog. Doctorado: FÍSICA APLICADA Y TECNOLOGÍA (R.D. 99/2011) - Tutor

GESTIÓN

Cargos académicos

IP del Proyecto (E2) de Refª. H2020-MSCA-COFUND-2020 (8923) Low dimensional Materials efficient Neur

IP del Proyecto (N1) de Refª. PID2021-126483OB-I00 Transistores FET basados en Si y materiales 2d av

Dirección TERATECH25

IP del Proyecto (N1) de Refª. PDC2023-145856-I00 Prototipo de detector avanzado en la banda de terah

Apellidos y nombre: Moreno Vázquez, María
Departamento: Física Aplicada
Área de conocimiento: Electrónica
Categoría: Profesor Permanente Laboral Titular

DOCENCIA (titulación y asignatura)

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA - PERIFÉRICOS

MÁSTER U. EN FÍSICA Y MATEMÁTICAS - MATERIALES PARA LA NANOTECNOLOGÍA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGÍAS ELECTRÓNICAS - TECNOLOGÍAS DE MICRO Y
NANOFABRICACIÓN ELECTRÓNICA

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN - FÍSICA

GRADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES - INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA

DOBLE TITULACIÓN ING. INFORM. SISTEMAS INFORMACIÓN/GR. INFORMA. Y DOCUMENT. - FÍSICA

DOBLE TITULACIÓN GR. EN ING.DE MATERIALES/ GR. EN ING. MECÁNICA - INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA

INVESTIGACIÓN

Grupo de Investigación

Investigador del Grupo de Investigación: Nanoelectrónica para tecnología de terahercios

Lineas de investigación:

- Dispositivos para la tecnología de Terahercios - Optoelectrónica - Nano/Micro-electrónica - Materiales 2D - Simulación - Dispositivos de memoria

Proyectos

Transistores FET basados en Si y materiales 2d avanzados para tecnología super-Terahercios

Prototipo de detector avanzado en la banda de terahercios para aplicaciones de seguridad e imágenes (PrDATA)

Programas de doctorado

No constan

GESTIÓN

Cargos académicos

No constan

Apellidos y nombre: Pascual Corral, Elena
Departamento: Física Aplicada
Área de conocimiento: Electrónica
Categoría: Profesor Titular de Universidad

DOCENCIA (titulación y asignatura)

GRADO EN FÍSICA - LABORATORIO DE FISICA

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA - PRÁCTICAS EXTERNAS

DOBLE TITULACIÓN GRADO EN FÍSICA Y MATEMÁTICAS - LABORATORIO DE FISICA

MÁSTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGÍAS ELECTRÓNICAS - ELECTRÓNICA PARA COMPUTACIÓN NEUROMÓRFICA

MÁSTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGÍAS ELECTRÓNICAS - PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS
MU PROFESOR E.S.O. Y BACHILLERATO, FORM. PROF. Y E. IDIOMAS - INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN LA ESPECIALIDAD EN TECNOLOGÍA

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN - ARQUITECTURA DE COMPUTADORES I

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA - FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA

GRADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES - FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA

DOBLE TITULACIÓN ING. INFORM. SISTEMAS INFORMACIÓN/GR. INFORMA. Y DOCUMENT. - ARQUITECTURA DE COMPUTADORES I

DOBLE TITULACIÓN GR. EN ING.DE MATERIALES/ GR. EN ING. MECÁNICA - FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA

INVESTIGACIÓN

Grupo de Investigación

Investigador del Grupo de Investigación: Nanodispositivos electrónicos de alta frecuencia

Líneas de investigación:

Diseño y simulación de nanodispositivos electrónicos de alta frecuencia Caracterización DC, RF y de ruido de dispositivos electrónicos Ruido en materiales y dispositivos semiconductores Modelado de grafeno (monocapa y bicapa) y dispositivos de grafeno par

Proyectos

GIRLS: Generación para la innovación, resiliencia, liderazgo y sostenibilidad. ¡Que empiece el juego!

Plantillas electrónicas con percepción táctil

Programas de doctorado

Prog. Doctorado: INGENIERÍA INFORMÁTICA (R.D.99/2011) - DirectorTesis

GESTIÓN

Cargos académicos

Dtor. Título Propio: Especialista Universitario en Aviación Comercial- Piloto de Transporte de L. A.

Responsable Técnico de la Materia "Física"

VOCAL COMISIONES DE GRADO - GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA - ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ZAMORA

IP del Proyecto (N1) de Refª. TED2021-131766A-I00 Plantillas electrónicas con percepción táctil

Apellidos y nombre: Pérez Santos, María Susana
Departamento: Física Aplicada
Área de conocimiento: Electrónica
Categoría: Catedrático de Universidad

DOCENCIA (titulación y asignatura)

GRADO EN FÍSICA - INSTRUMENTACION ELECTRONICA

GRADO EN FÍSICA - SISTEMA ELECTRONICOS DIGITALES

DOBLE TITULACIÓN GRADO EN FÍSICA Y MATEMÁTICAS - INSTRUMENTACION ELECTRONICA

MÁSTER U. EN FÍSICA Y MATEMÁTICAS - FÍSICA DE SENSORES

MÁSTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGÍAS ELECTRÓNICAS - OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA EN ELECTRÓNICA DE POTENCIA

MÁSTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGÍAS ELECTRÓNICAS - TEMAS DE VANGUARDIA EN ELECTRÓNICA SOSTENIBLE

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA - ELECTRÓNICA Y ELECTROTECNIA

INVESTIGACIÓN

Grupo de Investigación

Investigador del Grupo de Investigación: Nanodispositivos electrónicos de alta frecuencia

Líneas de investigación:

Diseño y simulación de nanodispositivos electrónicos de alta frecuencia Caracterización DC, RF y de ruido de dispositivos electrónicos
Ruido en materiales y dispositivos semiconductores Modelado de grafeno (monocapa y bicapa) y dispositivos de grafeno par

Proyectos

Vertical Gallium Nitride Power MOSFETs (SGT-MOSFET)

Nuevas soluciones con diodos y transistores para sensado y comunicaciones de banda ancha en el rango THz

Caracterización, análisis e intervención en la prevención de riesgos laborales en entornos de trabajo tradicionales mediante la aplicación de tecnologías disruptivas

Mejora de la tecnología de diodos de barrera Schottky de GaN para electrónica eficiente de alta potencia

Diodos Gunn planares de GaN con terminal de sustrato para generación de alta potencia en el rango de sub-THz

Programas de doctorado

Prog. Doctorado: FÍSICA APLICADA Y TECNOLOGÍA (R.D. 99/2011) - Director Tesis

Prog. Doctorado: FÍSICA APLICADA Y TECNOLOGÍA (R.D. 99/2011) - Tutor

GESTIÓN

Cargos académicos

Vocal Programa ACADEMIA (ANECA). Comisión 12. INGENIERÍA ELECTRÓNICA

VOCAL COMISIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DELEGADA CONSEJO DE GOBIERNO

IP del Proyecto (E2) de Refª. H2020-MSCA-COFUND-2020 (8934) Vertical Gallium Nitride Power MOSFETs (

Apellidos y nombre: Rengel Estévez, Raúl
Departamento: Física Aplicada
Área de conocimiento: Electrónica
Categoría: Catedrático de Universidad

DOCENCIA (titulación y asignatura)

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA - FUNDAMENTOS FÍSICOS
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA - SISTEMAS DIGITALES PROGRAMABLES
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA - PRÁCTICAS EXTERNAS
MÁSTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGÍAS ELECTRÓNICAS - COMPLEMENTOS FORMATIVOS EN CIRCUITOS DIGITALES
MÁSTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGÍAS ELECTRÓNICAS - MATERIALES SEMICONDUCTORES
MÁSTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGÍAS ELECTRÓNICAS - DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS
MÁSTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGÍAS ELECTRÓNICAS - SENSORES DE IMAGEN Y DISPLAYS
MÁSTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGÍAS ELECTRÓNICAS - CIRCUITOS DIGITALES INTEGRADOS
MÁSTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGÍAS ELECTRÓNICAS - DISEÑO DE SISTEMAS DIGITALES ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES
MÁSTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGÍAS ELECTRÓNICAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS Y OPTOELECTRÓNICOS
MÁSTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGÍAS ELECTRÓNICAS - SENSORES INTELIGENTES Y ELECTRÓNICA PARA IoT
MÁSTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGÍAS ELECTRÓNICAS - TRABAJO FIN DE MÁSTER
DOBLE TITULACIÓN GRADO EN ADE E INGENIERÍA INFORMÁTICA - FUNDAMENTOS FÍSICOS

INVESTIGACIÓN

Grupo de Investigación

Investigador del Grupo de Investigación: Nanodispositivos electrónicos de alta frecuencia

Líneas de investigación:

Diseño y simulación de nanodispositivos electrónicos de alta frecuencia Caracterización DC, RF y de ruido de dispositivos electrónicos
Ruido en materiales y dispositivos semiconductores Modelado de grafeno (monocapa y bicapa) y dispositivos de grafeno par

Proyectos

No constan

Programas de doctorado

Prog. Doctorado: FÍSICA APLICADA Y TECNOLOGÍA (R.D. 99/2011) - Director Tesis

GESTIÓN

Cargos académicos

Dtor. Máster Tipo 1 MU Semiconductores y Tecnologías Electrónicas

VOCAL COMISIONES DE GRADO - GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA - FACULTAD DE CIENCIAS

Apellidos y nombre: Velázquez Pérez, Jesús Enrique
Departamento: Física Aplicada
Área de conocimiento: Electrónica
Categoría: Profesor Titular de Universidad

DOCENCIA (titulación y asignatura)

GRADO EN FÍSICA - INSTRUMENTACION ELECTRONICA
GRADO EN FÍSICA - ELECTRONICA DE COMUNICACIONES
GRADO EN FÍSICA - PRACTICAS EXTERNAS III (12 Créditos)
DOBLE TITULACIÓN GRADO EN FÍSICA Y MATEMÁTICAS - INSTRUMENTACION ELECTRONICA
MÁSTER U. EN FÍSICA Y MATEMÁTICAS - CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y DISPOSITIVOS
MÁSTER U. EN FÍSICA Y MATEMÁTICAS - FÍSICA DE SENSORES
MÁSTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGÍAS ELECTRÓNICAS - TECNOLOGÍAS DE MICRO Y NANOFABRICACIÓN ELECTRÓNICA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN SEMICONDUCTORES Y TECNOLOGÍAS ELECTRÓNICAS - DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS EMERGENTES

INVESTIGACIÓN

Grupo de Investigación

Investigador del Grupo de Investigación: GRUPO DE NANOTECNOLOGÍA Y MATERIALES CUÁNTICOS

Lineas de investigación:

Coloides e Interfases Nanosistemas cuánticos y Física No Lineal Terahercios y Células solares Materiales Cuánticos, grafeno y otros materiales 2D Twistrónica y nanodispositivos cuánticos Materiales para la energía Física de Superficies y caracterización a

Investigador Principal del Grupo de Investigación: Nanoelectrónica para tecnología de terahercios

Lineas de investigación:

Coloides e Interfases Nanosistemas cuánticos y Física No Lineal Terahercios y Células solares Materiales Cuánticos, grafeno y otros materiales 2D Twistrónica y nanodispositivos cuánticos Materiales para la energía Física de Superficies y caracterización a

Proyectos

Transistores FET basados en Si y materiales 2d avanzados para tecnología super-Terahercios

Materiales Cuánticos para Nanodispositivos y Celulas Solares de Nueva Generación (CuNaSol)

Prototipo de detector avanzado en la banda de terahercios para aplicaciones de seguridad e imágenes (PrDATA)

Programas de doctorado

Prog. Doctorado: FÍSICA APLICADA Y TECNOLOGÍA (R.D. 99/2011) - Tutor

Prog. Doctorado: FÍSICA APLICADA Y TECNOLOGÍA (R.D. 99/2011) - DirectorTesis

Prog. Doctorado: FÍSICA APLICADA Y TECNOLOGÍA (R.D. 99/2011) - CodirectorTesis

GESTIÓN

Cargos académicos

IP del Proyecto (N1) de Refª. PID2021-126483OB-I00 Transistores FET basados en Si y materiales 2d av

IP del Proyecto (N1) de Refª. PDC2023-145856-I00 Prototipo de detector avanzado en la banda de terah

VOCAL COMISIONES DE DOCTORADO - FÍSICA APLICADA Y TECNOLOGÍA (R.D. 99/2011)

VOCAL COMISIONES DE GRADO - GRADO EN FÍSICA - FACULTAD DE CIENCIAS